



# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 17/15

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
29. November 2016

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2014 213 375.0**

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. November 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Strößner und der Richter Dr. Friedrich, Dr. Zebisch und Dr. Himmelmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2014 213 375.0 und der Bezeichnung „Mikroelektronisches System mit erhöhter Sicherheit vor Datenmissbrauch und Produktmanipulation und Verfahren zur Herstellung desselben“ wurde am 9. Juli 2014 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der Anmeldung 10 2014 207 625.0 vom 23. April 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Gleichzeitig mit der Anmeldung wurde Prüfungsantrag gestellt.

Die Prüfungsstelle für Klasse H01L hat im Prüfungsverfahren den Stand der Technik gemäß den Druckschriften

- D1 US 2011 / 0 227 603 A1
- D2 DE 693 32 482 T2
- D3 WOLF, M.J. [u.a.]: Technologies for 3D Wafer Level Heterogeneous Integration. In: DTIP of MEMS & MOEMS, 2008, S. 123 - 126
- D4 RODRIGUEZ, R.I.; IBITAYO, D.; QUINTERO, P. O.: Thermal Stability Characterization of the Au-Sn Bonding for High-Temperature Applications. In: IEEE Transactions On Components, Packaging and Manufacturing Technology, Vol. 3, No. 4, 2013, S. 549 - 557
- D5 US 5 072 331

berücksichtigt und im einzigen Prüfungsbescheid vom 30. Oktober 2014 neben Bedenken zur Ausführbarkeit insbesondere darauf hingewiesen, dass die Vor-

richtungen der selbständigen Ansprüche 1, 9 und 37 sowie das Herstellungsverfahren nach Anspruch 38 jeweils nicht neu bezüglich der Druckschrift D3 seien. Dem hat die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 9. April 2015 bei gleichzeitiger Einreichung eines neuen Anspruchs 1 widersprochen, woraufhin die Prüfungsstelle die Anmeldung in der Anhörung vom 26. Mai 2015, in der die Anmelderin zusätzlich neue Ansprüche 1 als Hilfsanträge 1 bis 4 eingereicht hat, mit der Begründung fehlender Neuheit bezüglich der Druckschrift D3 zurückgewiesen hat. Ihre Entscheidung hat die Prüfungsstelle mit Beschluss vom selben Tag schriftlich begründet.

Gegen diesen, dem Vertreter der Anmelderin am 12. Juni 2015 zugestellten Beschluss richtet sich die am 9. Juli 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde mit der nachgereichten Beschwerdebegründung vom 8. Juli 2016.

Zur mündlichen Verhandlung am 29. November 2016 ist, wie zuvor mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2016 angekündigt, kein Vertreter der ordnungsgemäß geladenen Anmelderin erschienen.

Sie beantragt mit Schriftsatz vom 8. Juli 2016 sinngemäß:

**1.**

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Mai 2015 aufzuheben.

**2.a) Hauptantrag**

Ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung „Mikroelektronisches System mit erhöhter Sicherheit vor Datenmissbrauch und Produktmanipulation und Verfahren zur Herstellung desselben“, dem Anmeldetag 9. Juli 2014 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität

10 2014 207 625.0 vom 23. April 2014 auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 38 gemäß Hauptantrag, eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am 10. April 2015;
- Beschreibungsseiten 1 bis 23, eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am Anmeldetag;
- 1/12 bis 12/12 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1A bis 10, eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am 23. Oktober 2014.

### **2.b) Hilfsantrag 1**

Hilfsweise für die unter 2.a) genannte technische Neuerung ein Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

- Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, überreicht in der Anhörung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt am 26. Mai 2015;
- Patentansprüche 2 bis 38 gemäß Hauptantrag, eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am 10. April 2015;
- die unter 2.a) genannten Beschreibungsseiten und Zeichnungen;

### **2.c) Hilfsantrag 2**

Weiter hilfsweise für die unter 2.a) genannte technische Neuerung ein Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

- Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2, überreicht in der Anhörung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt am 26. Mai 2015;
- Patentansprüche 2 bis 38 gemäß Hauptantrag, eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am 10. April 2015;
- die unter 2.a) genannten Beschreibungsseiten und Zeichnungen;

### **2.d) Hilfsantrag 3**

Weiter hilfsweise für die unter 2.a) genannte technische Neuerung ein Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

- Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3, überreicht in der Anhörung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt am 26. Mai 2015;
- Patentansprüche 2 bis 38 gemäß Hauptantrag, eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am 10. April 2015;
- die unter 2.a) genannten Beschreibungsseiten und Zeichnungen;

### **2.e) Hilfsantrag 4**

Weiter hilfsweise für die unter 2.a) genannte technische Neuerung ein Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

- Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4, überreicht in der Anhörung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt am 26. Mai 2015;
- Patentansprüche 2 bis 38 gemäß Hauptantrag, eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am 10. April 2015;
- die unter 2.a) genannten Beschreibungsseiten und Zeichnungen.

Der Anspruch 1 des **Hauptantrags** hat unter Hinzufügung einer Gliederung folgenden Wortlaut:

„Vorrichtung (4) mit elektrischer Funktionalität,

- (a) wobei die Vorrichtung (4) zumindest zwei gestapelte Bausteine (5a-b) aufweist, die ausgebildet sind, um jeweils eine elektrische Teilfunktionalität der Vorrichtung (4) derart auszuführen, dass die elektrische Funktionalität der Vorrichtung (4) nur in einem verbundenen Zustand der Bausteine (5a-b) durch Zusammenwirken der elektrischen Teilfunktionalitäten ausführbar ist,
- (b) wobei die Bausteine (5a-b) derart miteinander verbunden sind, dass die Bausteine (5a-b) nicht mehr getrennt werden können, oder nur noch derart

getrennt werden können, dass zumindest einer der beiden Bausteine nicht mehr funktionsfähig ist, wobei bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung der Vorrichtung (4) Verbindungen zwischen den einzelnen Bausteinen (5a-b) unzugänglich sind,

- (c) wobei die elektrische Funktionalität der Vorrichtung (4) durch mehrere Prozesse gebildet wird, die in Teilprozesse aufgeteilt und in den Bausteinen (5a-b) verteilt ausgeführt werden.“

**Anspruch 1 des Hilfsantrags 1** ergibt sich aus Anspruch 1 des Hauptantrags, indem dessen Merkmal (c) durch folgende Merkmale (c') und (d') ersetzt wird:

- (c') „wobei die elektrische Funktionalität der Vorrichtung (4) durch zumindest einen Prozess gebildet wird, der in Teilprozesse aufgeteilt und in den Bausteinen (5a-b) verteilt ausgeführt wird,
- (d') wobei weder der erste noch der zweite elektrische Baustein den Prozess ohne eine korrekte elektrische Verbindung zu dem jeweils anderen elektrischen Baustein ausführt.“

**Anspruch 1 des Hilfsantrags 2** ergibt sich aus Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, indem dessen Merkmal (c') durch folgendes Merkmal (c'') ersetzt wird:

- (c'') „wobei die elektrische Funktionalität der Vorrichtung (4) durch zumindest einen Prozess gebildet wird, der in Teilprozesse aufgeteilt ist, wobei die Vorrichtung ausgebildet ist, um die Teilprozesse in den Bausteinen (5a-b) verteilt auszuführen,“.

**Anspruch 1 des Hilfsantrags 3** ergibt sich aus Anspruch 1 des Hilfsantrags 2, indem folgendes Merkmal (e) angefügt wird:

- (e) „wobei eine Mehrzahl der Teilprozesse des ersten Bausteins und ein Teilprozess des zweiten Bausteins oder ein Teilprozess des ersten Bausteins und eine Mehrzahl der Teilprozesse des zweiten Bausteins nur in Kombination des Teilprozesses und der Mehrzahl der Teilprozesse des jeweils anderen Bausteins einen Rückschluss auf die elektrische Funktionalität geben.“

**Anspruch 1 des Hilfsantrags 4** ergibt sich aus Anspruch 1 des Hilfsantrags 2, indem folgendes Merkmal (e') angefügt wird:

(e') „wobei ein Teilprozess des ersten Bausteins und ein Teilprozess des zweiten Bausteins nur in Kombination mit dem Teilprozess des jeweils anderen Bausteins einen Rückschluss auf die elektrische Funktionalität gibt.“.

Hinsichtlich der abhängigen Ansprüche sowie der selbständigen Ansprüche 9, 37 und 38 des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 4 sowie bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie erweist sich aber als nicht begründet, da die mit den Ansprüchen 1 des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 4 beanspruchten Vorrichtungen durch den Stand der Technik gemäß der Druckschrift D3 neuheitsschädlich vorweggenommen werden, so dass diese gemäß § 3 PatG wegen fehlender Neuheit nicht patentfähig sind.

Bei dieser Sachlage kann die Zulässigkeit der geltenden Patentansprüche dahingestellt bleiben (*vgl. BGH GRUR 1991, 120-122, insbesondere 121, II.1 - Elastische Bandage*).

Der zuständige Fachmann ist hier als ein berufserfahrener Physiker oder Ingenieur der Elektrotechnik mit Hochschulabschluss und mit mehrjähriger Erfahrung in der Halbleiter- und Halbleitermodultechnik zu definieren.

2. Die Anmeldung betrifft eine Vorrichtung mit elektrischer Funktionalität und mit erhöhter Sicherheit vor Datenmissbrauch und Produktmanipulation sowie ein Verfahren zur Herstellung derselben.

Mikroelektronische Produkte können Angriffen ausgesetzt sein, mit denen gespeicherte Daten ausgelesen und manipuliert oder technologische Herstellungsprozesse untersucht werden sollen, bspw. durch das sogenannte „Reverse Engineering“, bei dem Wettbewerbsprodukte zerlegt werden, um daraus Konstruktions- und Fertigungsprinzipien entnehmen zu können. Diesen Angriffen kann durch Datenverschlüsselung, den Einsatz umfangreicher Pin-Codes und die Erhöhung der Komplexität des Schichtaufbaus des mikrologischen Systems entgegengewirkt werden, indem bspw. spezifische Schutzstrukturen und/oder eine erhöhte Schaltungs- und Verdrahtungs- bzw. Metallisierungskomplexität der elektronischen Schaltung vorgesehen sind.

Jedoch ist nach den Ausführungen in der Anmeldung ein angemessener physikalischer Schutz der Daten bisher nicht bekannt, *vgl. Beschreibungsseite 1, Zeilen 8 bis 22.*

Vor diesem Hintergrund liegt der Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, eine mikroelektronische Vorrichtung mit verbesserter Sicherheitsfunktion zu schaffen, *vgl. Beschreibungsseite 1, Zeilen 24 und 25.*

Diese Aufgabe wird gemäß Hauptantrag durch die Vorrichtungen der selbständigen Patentansprüche 1, 9 und 37 sowie das Herstellungsverfahren des Anspruchs 38 gelöst. Hilfsweise wird die Aufgabe auch durch die Vorrichtungen der jeweiligen Ansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 4 gelöst.

Die Vorrichtungen der jeweiligen Ansprüche 1 des Hauptantrags und der Hilfsanträge zeichnen sich hinsichtlich ihrer gegenständlichen Merkmale dadurch aus, dass die Vorrichtung mit elektrischer Funktionalität zumindest zwei gestapelte

Bausteine aufweist, die derart miteinander verbunden sind, dass die Bausteine nur noch derart getrennt werden können, dass zumindest einer der beiden Bausteine nicht mehr funktionsfähig ist, und dass zum Anderen bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung der Vorrichtung die Verbindungen zwischen den einzelnen Bausteinen unzugänglich sind. In der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 15, Zeile 25 bis Seite 16, Zeile 30 wird dies folgendermaßen erläutert:

*„Die Verbindungsmaterialien 30a-b können derart ausgebildet sein, dass zwei verbundene Bausteine nicht mehr getrennt werden können, oder nur noch derart getrennt werden können, dass zumindest einer der beiden Bausteine nicht mehr funktionsfähig ist, beispielsweise können die Bausteine 5a-c mittels SLID Bonden aus z. B. einer Gold-Zinn-Verbindung oder einer Kupfer-Zinn-Verbindung verbunden sein. [...] Zwei Materialien, z. B. Kupfer und Zinn, werden in den Zwischenraum zwischen zwei Halbleitersubstraten 10a-c gebracht und dort erhitzt bzw. verschmolzen. Beide Materialien können einen niedrigeren Schmelzpunkt, z. B. 250-300°C, als die Halbleitersubstrate und die Kontaktstrukturen aufweisen, jedoch als Legierung den Schmelzpunkt der Schaltungen 15a-b übersteigen. Beispielsweise kann die Legierung  $Cu_3Sn$  einen Schmelzpunkt von 550-650°C aufweisen. Ebenso kann zumindest eines der Materialien, z. B. das Kupfer, eine ultra robuste Verbindung mit dem Material des Halbleiters, beispielsweise dem Silizium, eingehen. Ein Aufschmelzen der Verbindung kann demnach mit einer zumindest teilweisen Zerstörung der elektrischen Bausteine einhergehen, da dieselben, durch die zum Aufschmelzen der Verbindungsmaterialien benötigten Temperatur, beschädigt werden. Weiterhin kann die Legierung beispielsweise eine höhere Festigkeit aufweisen, als das angrenzende Halbleitermaterial, welches durch physikalische Krafteinwirkung, z. B. ein Aufbrechen der Verbindung, die Beschädigung des Halbleitersubstrats zur Folge haben kann.“*

Demnach lässt sich eine Verbindung mit einer Festigkeit entsprechend Merkmal (b) bspw. durch das sog. SLID Bonden mit Kupfer und Zinn herstellen, da sich dabei eine sehr robuste Verbindung der Bondmaterialien mit dem Halbleitermaterial

ausbildet und die aus den Bondmaterialien gebildete intermetallische Verbindung  $\text{Cu}_3\text{Sn}$  einen Schmelzpunkt von 550-650°C aufweist, so dass ein Aufschmelzen dieser Verbindung die elektrische Vorrichtung schädigen würde.

Bezüglich der elektrischen Funktionalität der Vorrichtung ist zudem wesentlich, dass die Gesamtfunktionalität der Vorrichtung durch mehrere, in Teilprozesse aufgeteilte und in den Bausteinen verteilt ausgeführte funktionale Prozesse gebildet wird, wobei die gestapelten Bausteine ausgebildet sind, um jeweils eine elektrische Teilfunktionalität der Vorrichtung derart auszuführen, dass die Gesamtfunktionalität der Vorrichtung nur in einem verbundenen Zustand der Bausteine durch Zusammenwirken der elektrischen Teilfunktionalitäten ausführbar ist.

**3.** Die Vorrichtungen nach den jeweiligen Ansprüchen 1 des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 4 sind hinsichtlich des auf den Anmelder zurückgehenden Zeitschriftenartikels D3 mit dem Titel „*Technologies for 3D Wafer Level Heterogeneous Integration*“ wegen fehlender Neuheit (§ 3 PatG) nicht patentfähig.

**3a.** Die Druckschrift D3 beschreibt auf den Seiten 125 und 126 unter Punkt 2.3 anhand der Figuren 3 und 4 die vertikale Integration von Halbleiter-Bausteinen mit Hilfe der ICV-SLID Technologie (Inter-Chip-Via Solid-Liquid-Interdiffusion) am Beispiel der aus Kupfer (Cu) und Zinn (Sn) als Bondmaterialien gebildeten intermetallischen Verbindung  $\text{Cu}_3\text{Sn}$ , vgl. Seite 126, linke Spalte, zweiter Absatz, was mit dem in der Anmeldung beschriebenen Verbindungsaufbau zwischen den gestapelten Bausteinen übereinstimmt.

So offenbart diese Druckschrift in den Worten des Anspruchs 1 nach Hauptantrag eine

Vorrichtung (vgl. S. 123, linke Spalte unter Punkt I., erster Satz: „[...] System in Package (SiP) solutions [...]“) mit elektrischer Funktionalität (vgl. das Abstract, letzter Satz: „[...] a post front-end 3D integration process which allows stacking of functional and tested FE-devices e.g. sensors, ASICs on wafer level [...]“),

- (a) wobei die Vorrichtung zumindest zwei gestapelte Bausteine (vgl. Fig. 4: „level 3 chip“, „level 2 chip“, „bottom Si, level 1“ [...]) aufweist, die ausgebildet sind, um jeweils eine elektrische Teilfunktionalität (vgl. S. 126, linke Spalte unter Punkt IV. Conclusion: „[...] The ICV stacking concept allows the combination of different devices (e.g. MEMS-sensor, DSP, RF transceiver, power supply).“) der Vorrichtung derart auszuführen, dass die elektrische Funktionalität der Vorrichtung nur im verbundenen Zustand der Bausteine durch Zusammenwirken der elektrischen Teilfunktionalitäten ausführbar ist (vgl. im Abstract den Begriff „3D system“ und die als Beispiel genannten Stapel-Bausteine: „MEMS-sensor, DSP, RF transceiver, power supply“),
- (b) wobei die Bausteine derart miteinander verbunden (vgl. Fig. 4: „Schematic ICV-SLID process“) sind, dass die Bausteine nicht mehr getrennt werden können, oder nur noch derart getrennt werden können, dass zumindest einer der beiden Bausteine nicht mehr funktionsfähig ist (ergibt sich aus dem ICV-SLID Prozess), wobei bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung der Vorrichtung Verbindungen (vgl. Fig. 4, Cu-Sn alloy, soldered pad bei den SLID-Kontakten, bspw. beim Inter Chip Via) zwischen den einzelnen Bausteinen („level 3 chip“, „level 2 chip“, ...) unzugänglich sind,
- (c) wobei die elektrische Funktionalität der Vorrichtung durch mehrere Prozesse gebildet wird, die in Teilprozesse aufgeteilt und in den Bausteinen verteilt ausgeführt werden.

Dabei ist hinsichtlich der Merkmale (a) und (c) anzumerken, dass die in der Druckschrift D3 unter Punkt 2.3 beschriebene vertikale Systemintegration elektrischer Bausteine, bei der, wie in Fig. 4 gezeigt, mehrere Bausteine gestapelt und mittels des ICV-SLID-Prozesses elektrisch und mechanisch miteinander verbunden werden, gerade dazu führt, dass die Vorrichtung eine elektrische Funktionalität aufweist, die durch die Teilfunktionalitäten der einzelnen Bestandteile der gestapelten Bausteine gebildet wird, vgl. die in der D3 aufgeführten Beispiele (sensors, ASICs,

MEMS-sensor, DSP, RF transceiver, power supply). Denn ohne die Teilfunktionalität einer Spannungsversorgung (power supply) gibt es keine Gesamtfunktion der Vorrichtung, und ohne eine Verbindung der Bausteine untereinander, bspw. vom ASIC zum MEMS-Sensor gibt es keine entsprechenden Daten für die Signalverarbeitung durch die ASICs. Somit erfolgt auch bei der in der Druckschrift D3 beschriebenen Vorrichtung ein Verarbeitungsprozess, indem die einzelnen Bausteine Teilprozesse dieses Verarbeitungsprozesses durchführen.

Die Vorrichtung des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist demnach wegen fehlender Neuheit bezüglich der Druckschrift D3 nicht patentfähig.

**3b.** Das geänderte Merkmal (c') des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 entspricht inhaltlich dem Merkmal (c) des Anspruchs 1 nach Hauptantrag und das Zusatzmerkmal (d') des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1, wonach weder der erste noch der zweite elektrische Baustein den Prozess ohne eine korrekte elektrische Verbindung zu dem jeweils anderen elektrischen Baustein ausführt, ist, wie zuvor am Beispiel der Verbindung der Bausteine zur Spannungsversorgung erläutert, eine Selbstverständlichkeit und aus der Druckschrift D3 bekannt.

Die Vorrichtung des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1 ist demnach wegen fehlender Neuheit bezüglich der Druckschrift D3 nicht patentfähig.

**3c.** Für das geänderte Merkmal (c'') des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2, wonach „die elektrische Funktionalität der Vorrichtung (4) durch zumindest einen Prozess gebildet wird, der in Teilprozesse aufgeteilt ist, wobei die Vorrichtung ausgebildet ist, um die Teilprozesse in den Bausteinen (5a-b) verteilt auszuführen“, gelten obige Ausführungen in gleicher Weise. Somit ist auch die Vorrichtung des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 2 wegen fehlender Neuheit bezüglich der Druckschrift D3 nicht patentfähig.

**3.d.** Die weiteren Merkmale (e) bzw. (e') der Ansprüche 1 der Hilfsanträge 3 und 4, die sich darauf beziehen, dass nur in Kenntnis der Teilprozesse des ersten und zweiten Bausteins ein Rückschluss auf die elektrische Funktionalität der Vorrichtung möglich sein soll, sind ebenfalls aus der D3 bekannt, denn wenn bspw. der Sensor oder der Baustein für die Spannungsversorgung der Vorrichtung aus der Druckschrift D3 bekannt ist, kann daraus noch nicht auf die Gesamtfunktionalität der Vorrichtung geschlossen werden.

Die Vorrichtung der jeweiligen Ansprüche 1 nach Hilfsantrag 3 bzw. 4 sind folglich ebenfalls wegen fehlender Neuheit bezüglich der Druckschrift D3 nicht patentfähig.

**4.** Es kann dahingestellt bleiben, ob die Vorrichtungen der selbständigen Ansprüche 9 und 37 bzw. der abhängigen Ansprüche 2 bis 8 und 10 bis 36 sowie das Herstellungsverfahren des Anspruchs 38 patentfähig sind, denn wegen der Antragsbindung im Patenterteilungsverfahren fallen mit dem Patentanspruch 1 sowohl die übrigen selbständigen Patentansprüche als auch die mittelbar oder unmittelbar auf die selbständigen Patentansprüche rückbezogenen Unteransprüche (vgl. *BGH GRUR 2007, 862, 863 Tz. 18 – Informationsübermittlungsverfahren II m. w. N.*).

**5.** Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

### **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin – vorbehaltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere des Vorliegens einer Beschwerde – das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich

1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist **innerhalb eines Monats** nach Zustellung des Beschlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des BGH, [www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html). Das elektronische Dokument ist mit einer prüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer prüfbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen. Die Eignungsvoraussetzungen für eine Prüfung und für die Formate des elektronischen Dokuments werden auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs [www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html) bekannt gegeben.

Dr. Strößner

Dr. Friedrich

Dr. Zebisch

Dr. Himmelmann

prä